

エキシトントランジスタ実現に向けたZnIn₀Nの創製

松島, 宏一

<https://doi.org/10.15017/1807054>

出版情報：九州大学, 2016, 博士（工学）, 課程博士
バージョン：
権利関係：全文ファイル公表済

氏名	松島宏一			
論文名	エキシトントランジスタ実現に向けた ZnInON の創製			
論文調査委員	主査	九州大学	教授	白谷正治
	副査	九州大学	准教授	中村大輔
	副査	九州大学	准教授	板垣奈穂
	副査	九州大学	准教授	古閑一憲

論文審査の結果の要旨

本研究は、不純物添加結晶化法という新規プロセスにより ZnInON という新材料の単結晶薄膜形成を実現し、これを用いた新構造の歪量子井戸型エキシトンデバイスでエキシトン流の変調に室温で成功したもので、電気電子工学上価値ある業績である。よって本論文は博士（工学）の学位に値するものと認める。